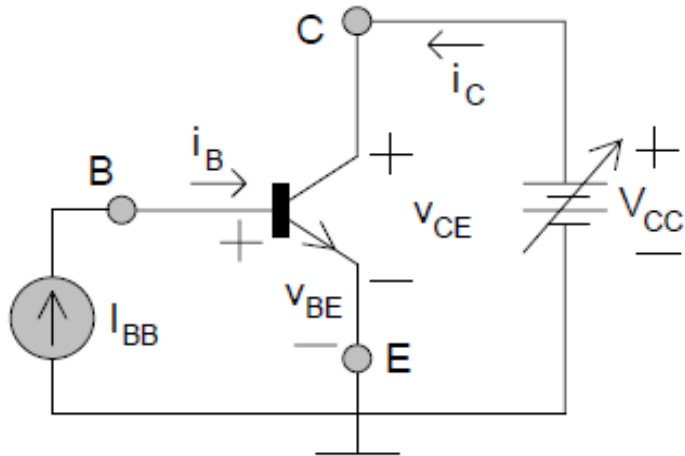
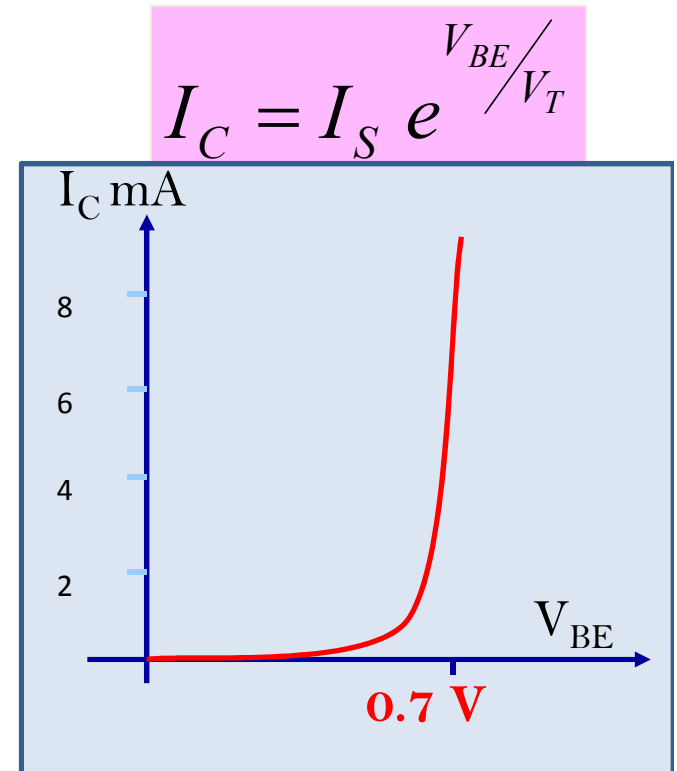
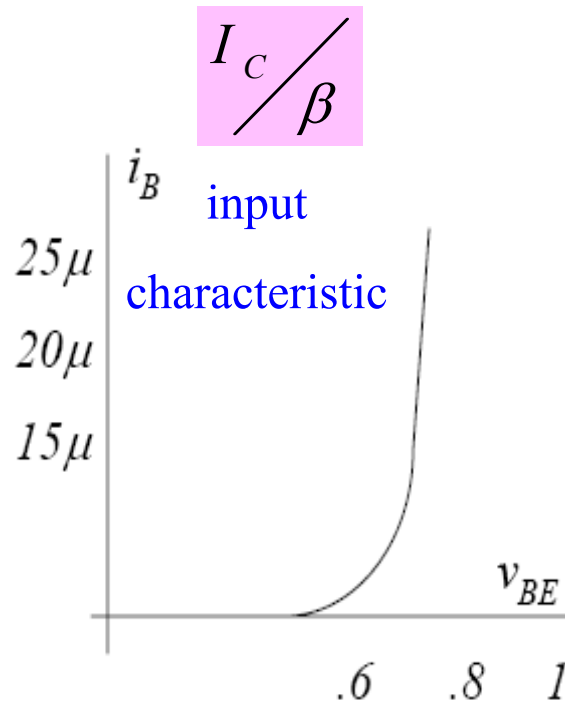
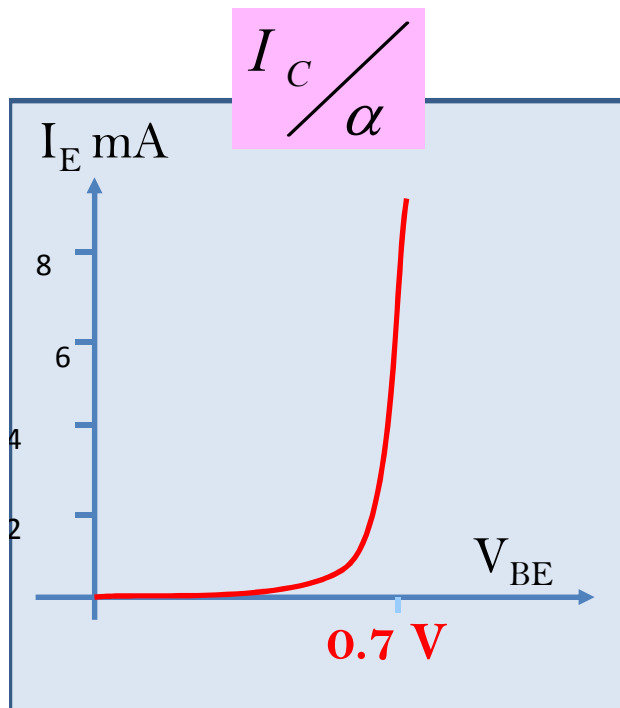


التمثيل البياني لخواص الترانزستور BJT الموصل بطريقة CE

Graphical Representation of BJT characteristics



العلاقة $i_E - v_{BE}$ ، العلاقة $i_B - v_{BE}$ و العلاقة $i_C - v_{BE}$ كلها أسية ولكن بمقاييس مختلفة.

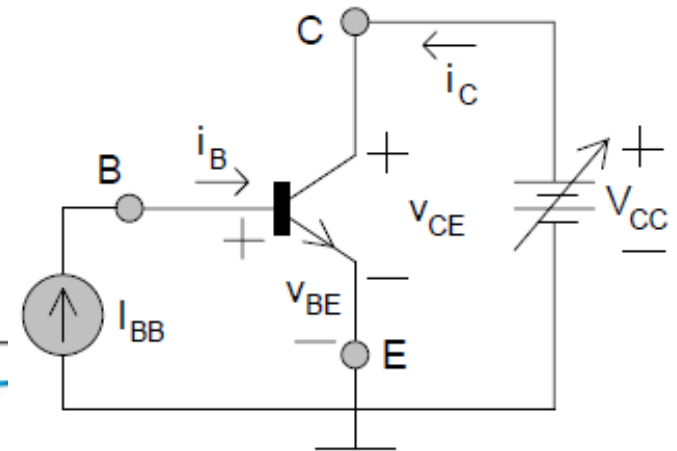
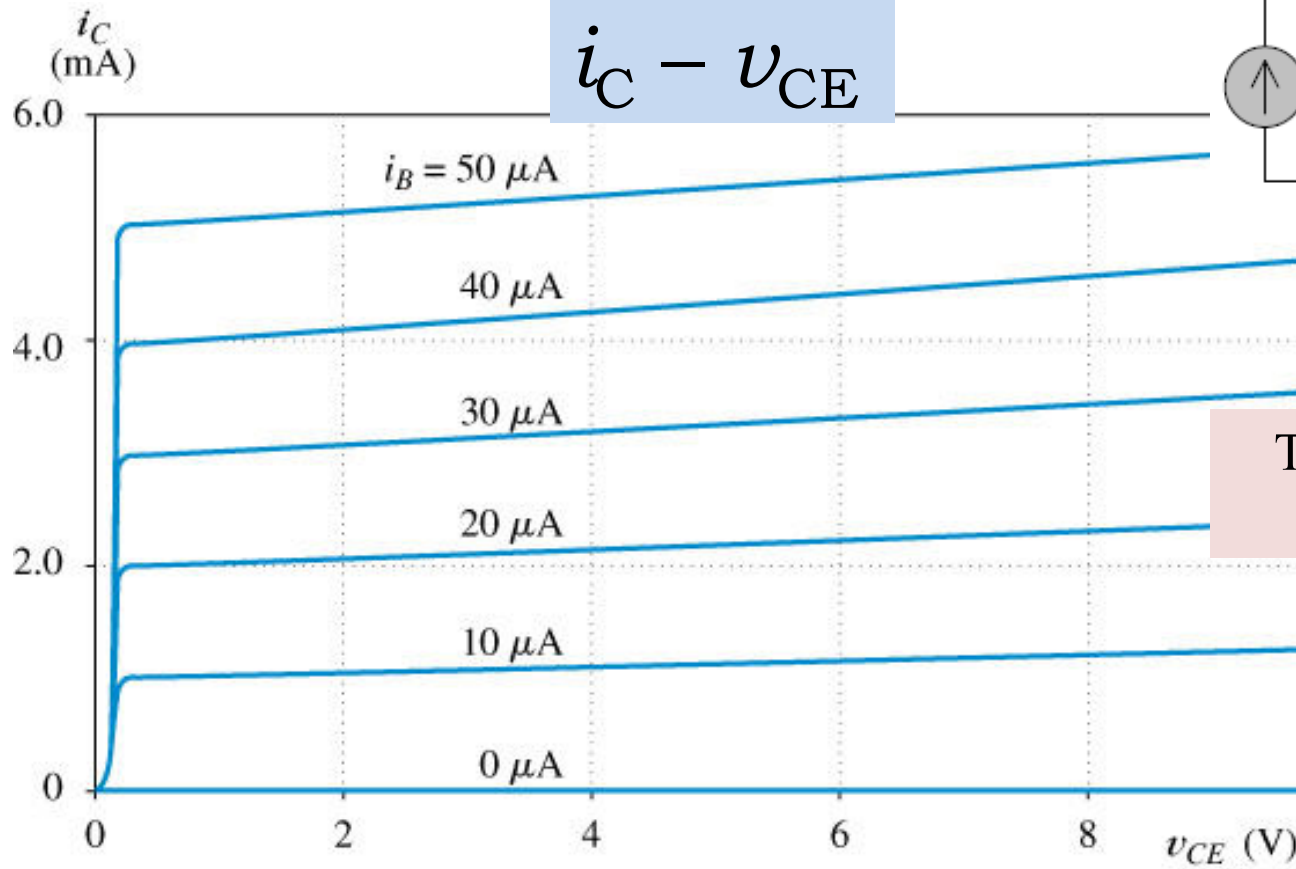


التمثيل البياني لخواص الترانزستور BJT الموصل بطريقة CE

Graphical Representation of BJT characteristics

output characteristics

$$i_C - v_{CE}$$



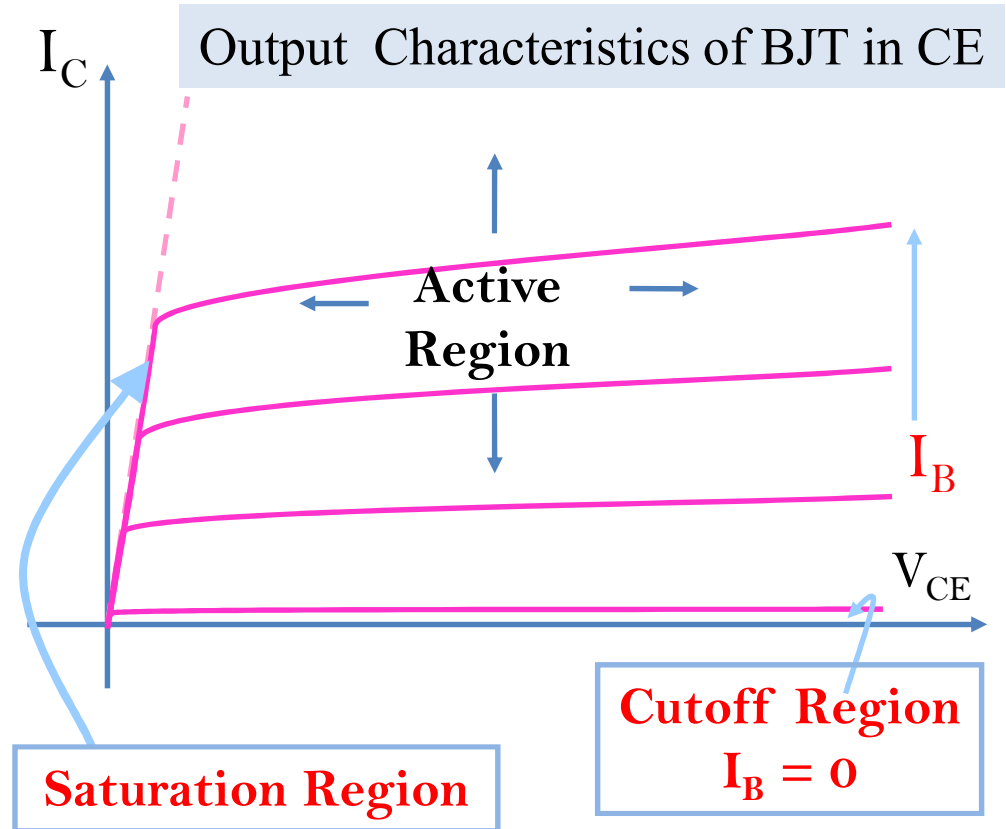
The collector behaves as a constant current source

تحديد مناطق تشغيل الترانزستور على منحنيات خواص الخرج

Mode	BEJ	CBJ
Cutoff	Reverse	Reverse
active	Forward	Reverse
Saturation	Forward	Forward

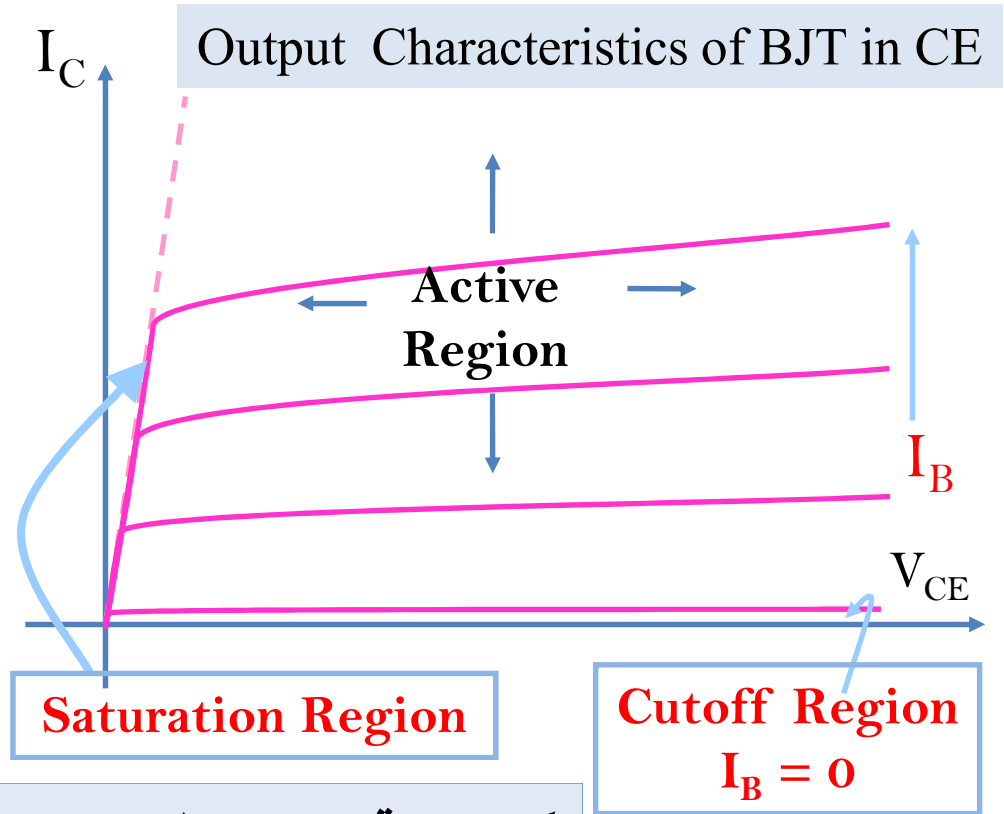
$$V_{CE} = V_{BE} + V_{CB}$$

Mode	V_{BE}	V_{CB}
Cutoff	-	+
active	+	+
Saturation	+	-



تحديد مناطق تشغيل الترانزستور على منحنيات خواص الخرج

Region	Description
Active	<u>Small</u> base current controls a <u>large</u> collector current
Saturation	$V_{CE(sat)} \sim 0.2V$, V_{CE} increases with I_C
Cutoff	Achieved by reducing I_B to 0, Ideally, I_C will also equal 0.

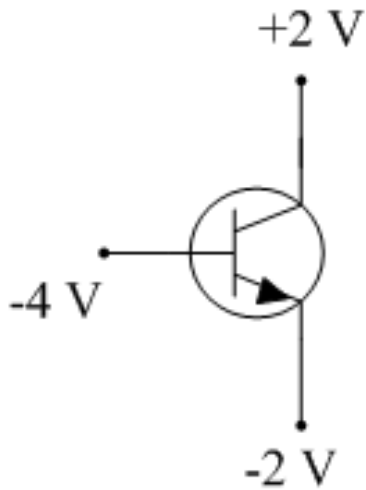


كيف تحدد منطقة تشغيل الترانزستور؟

V_{BE} (active) و $V_{CE}(sat)$ بمعرفة

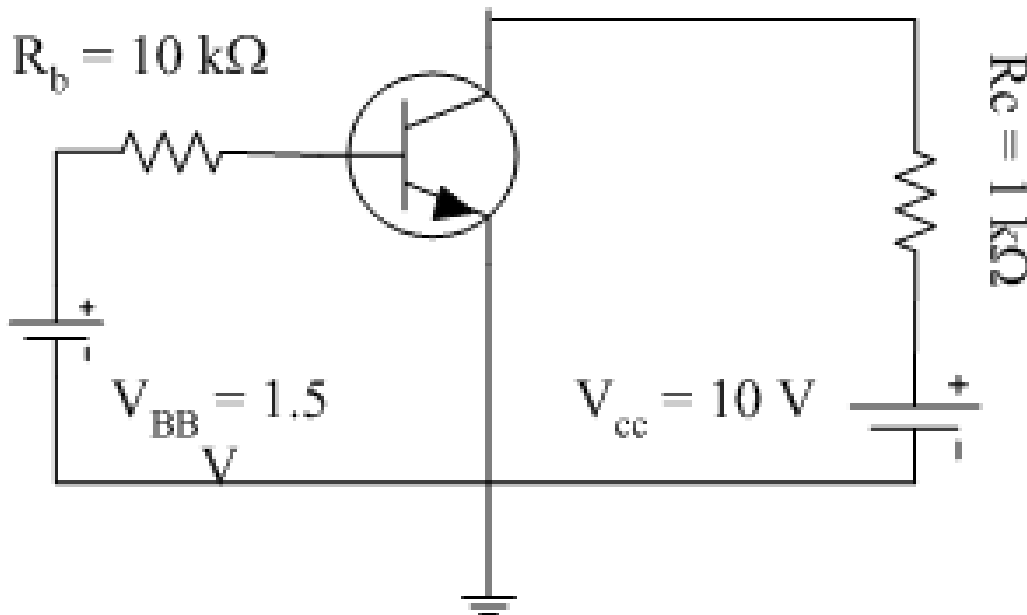
تدريب 1

حددي منطقة عمل الترانزستور الموصل كما في الدائرة.



تدريب 2

حددي منطقة عمل الترانزستور الموصل كما في الدائرة
حيث $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $\beta = 100$, $V_{CE(\text{sat})} = 0.1 \text{ V}$ الموضحة.

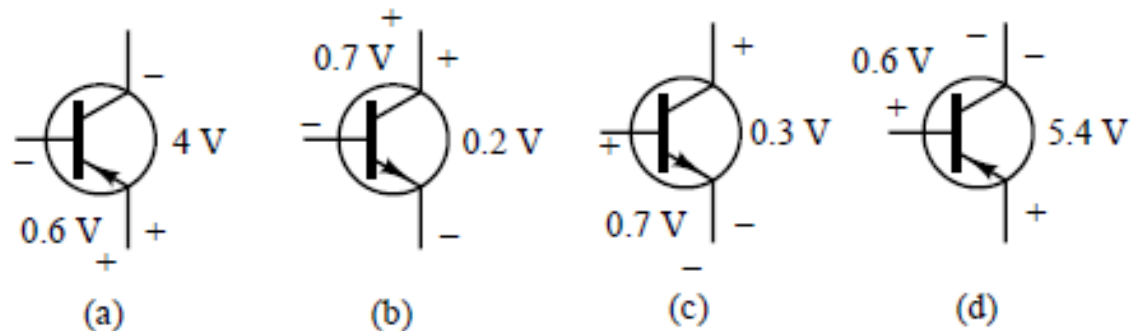


تحديد مناطق تشغيل الترانزستور

Determine the region of operation for the following transistors:

- nnp , $V_{BE} = 0.8 \text{ V}$, $V_{CE} = 0.4 \text{ V}$
- nnp , $V_{CB} = 1.4 \text{ V}$, $V_{CE} = 2.1 \text{ V}$
- pnp , $V_{CB} = 0.9 \text{ V}$, $V_{CE} = 0.4 \text{ V}$
- nnp , $V_{BE} = -1.2 \text{ V}$, $V_{CB} = 0.6 \text{ V}$

For each transistor shown in Figure P9.1, determine whether the BE and BC junctions are forward- or reverse-biased, and determine the operating region.

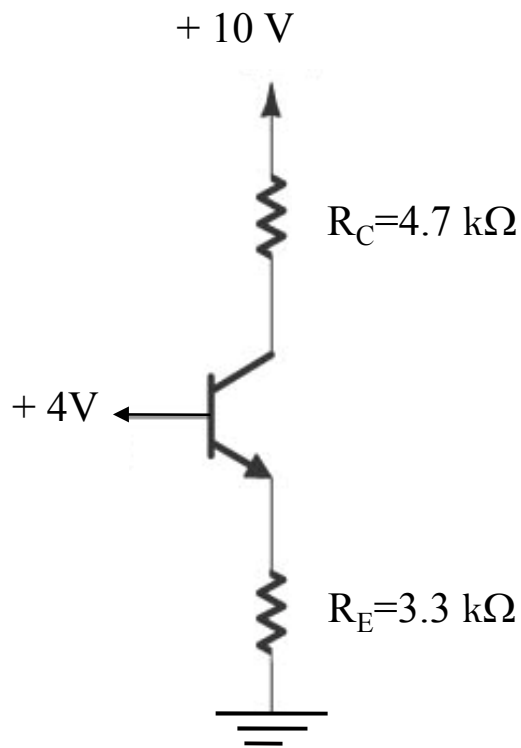


Analysis of Transistor Circuits at DC

تحليل دوائر الترانزستور للتيار المستمر

تحديد منطقة عمل الترانزستور

تعيين قيم جهود النقاط وتيارات الفروع الغير معلومة



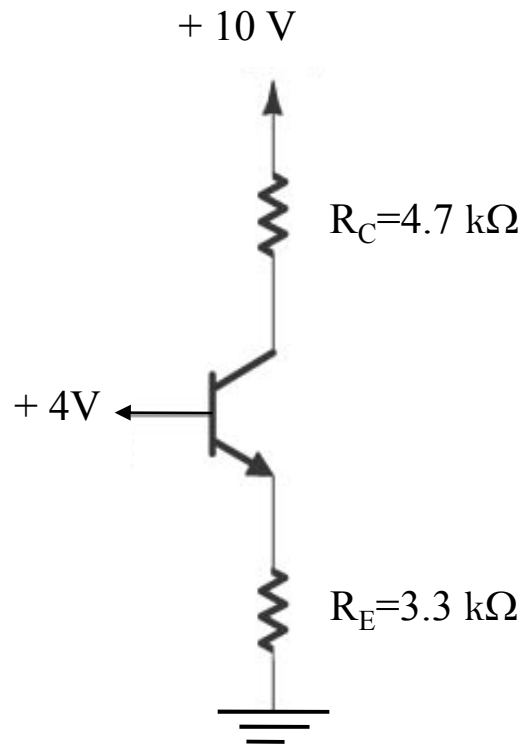
فرض ثبات الجهد V_{BE} عند القيمة 0.7 V

فرض قيمة $\beta = 100$

المطلوب

I_E, I_C, I_B

V_E, V_C



القاعدة موصلة بـ $+4 \text{ V}$ و الباعث بالأرضي

في الانحياز الأمامي BEJ

$$V_E = 4 - 0.7 = 3.3 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E - 0}{R_E}$$

$$I_E = \frac{3.3}{3.3 \times 1000} = 1 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E$$

The value of α is obtained from:

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{100}{101} \cong 0.99$$

Thus I_C will be:

$$I_C = 0.99 \times 1 = 0.99 \text{ mA}$$

3

To determine V_C :

$$V_C = 10 - I_C R_C$$

$$V_C = 10 - 0.00099 \times 47000$$

$$V_C = + 5.3 \text{ V}$$

4

Since B at +4 V, CBJ is reverse-biased

The Transistor is indeed in
the Active Mode

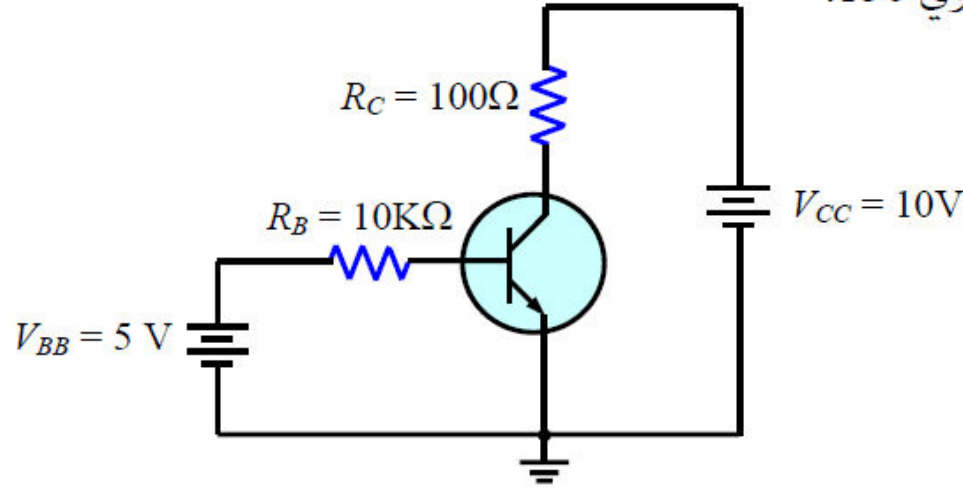
To determine I_B :

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{1}{101} \cong 0.01 \text{ mA}$$

5

E:4.8

مثال 4-2: أوجد قيمة كل من I_B و I_C و I_E و V_{BE} و V_{CE} و V_{CB} في الدائرة الموضحة بشكل (4-8) علماً بأن المعامل β_{dc} للترانزستور تساوي 150.



شكل (4-8)

الحل:

يمكن حساب التيارات I_B و I_C و I_E كالآتي:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5V - 0.7V}{10 \text{ K}\Omega} = 430 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_{dc} I_B = (150)(430 \mu\text{A}) = 64.5 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B = 64.5 \text{ mA} + 430 \mu\text{A} = 64.9 \text{ mA}$$

لحساب كل من V_{CE} و V_{CB} نطبق المعادلات التالية:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10V - (64.5 \text{ mA})(100\Omega) = 10V - 6.45V = 3.55 \text{ V}$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 3.55 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.85 \text{ V}$$

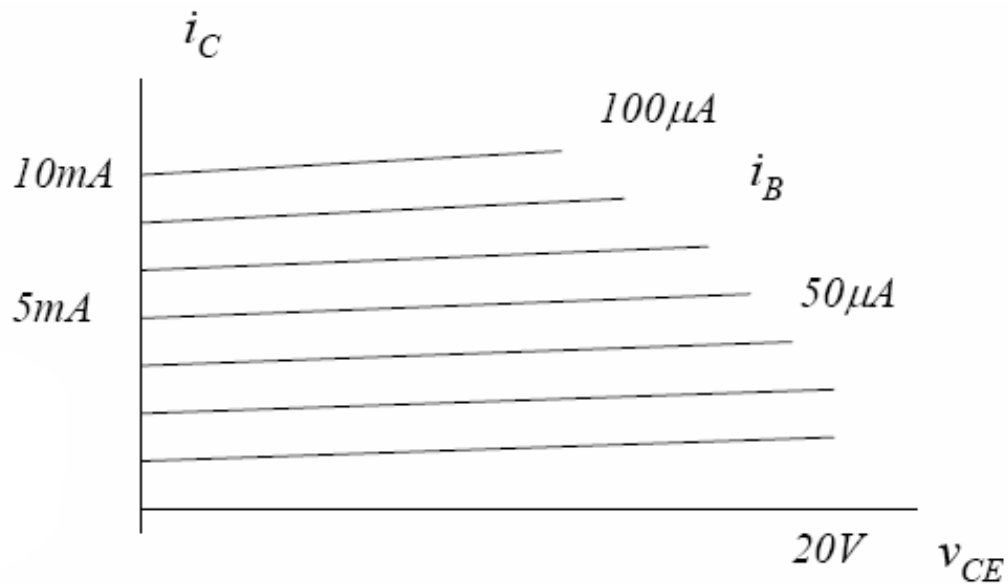
تدریب

Given: $I_B = 50 \mu A$, $I_C = 1 mA$

Find: I_E , β , and α

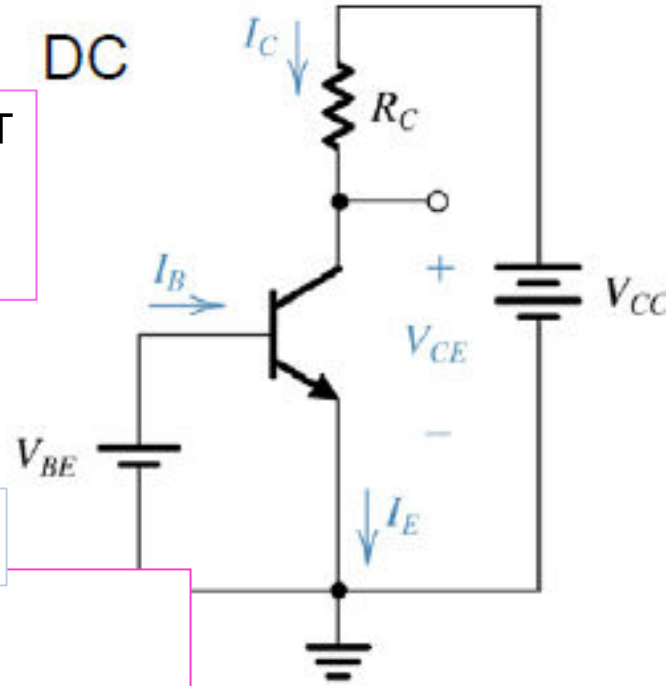
Solution:

Calculate the values of β and α from the transistor shown in the graph.

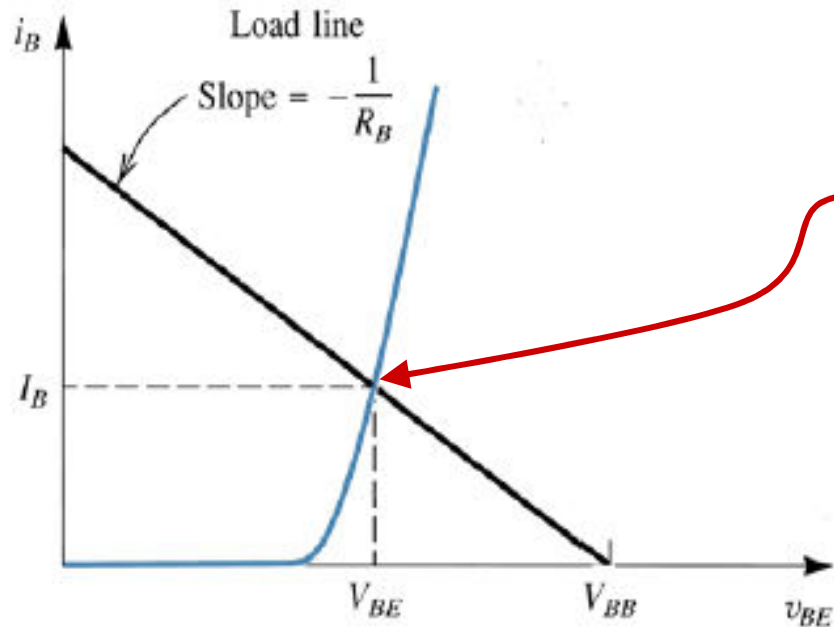


Calculating the Q-point for BJT is the first step in analyzing the circuit.

تحديد نقطة عمل الترانزستور

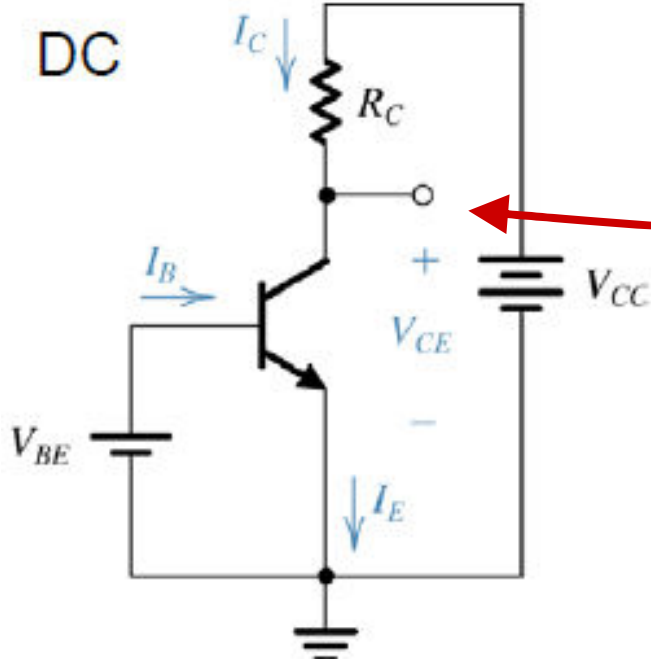


Base-Emitter Circuit Q point



تحديد النقطة Q على منحنى خواص الدخل $(I_B - V_{BE})$

التحليل بيانياً Graphical Analysis



بعد تحديد النقطة Q لدائرة القاعدة - الباعث،
نتنقل إلى دائرة المجمع - الباعث.

Now that we have the Q-point for the base circuit,
let's proceed to the collector circuit.

- نطبق KVL حول دائرة المجمع:

$$V_{CC} = i_C R_C + V_{CE}$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C}$$

- هذه معادلة خط الحمل الذي يتقاطع مع

محور I_C عند $\frac{V_{CC}}{R_C}$ ومع محور V_{CE} عند V_{CC}
بميل $-\frac{1}{R_C}$

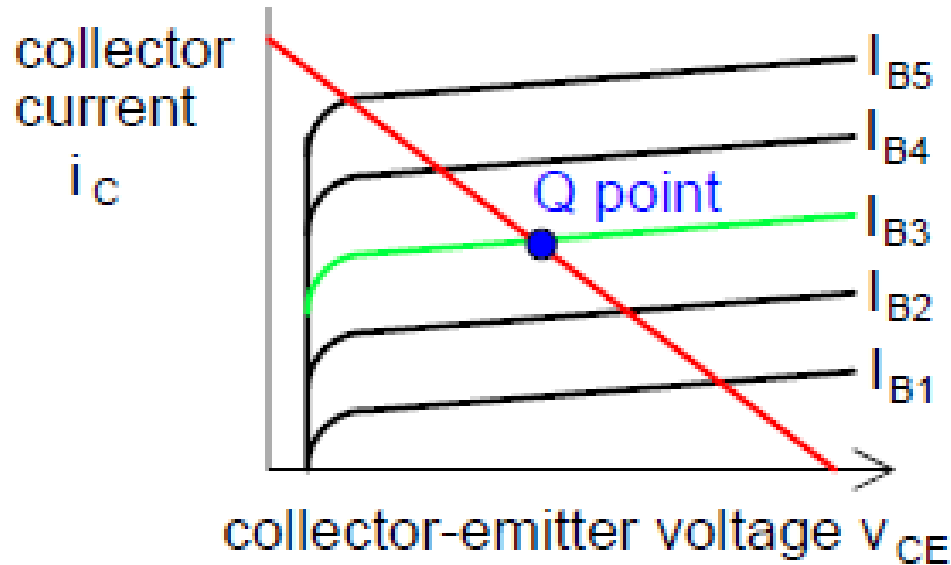
Apply KVL around the collector circuit:

• Rewrite as: $I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C}$

• This is a load-line curve, representing a line that intersects the I_C axis at V_{CC}/R_C and the V_{CE} axis at V_{CC} , with slope $-1/R_C$.

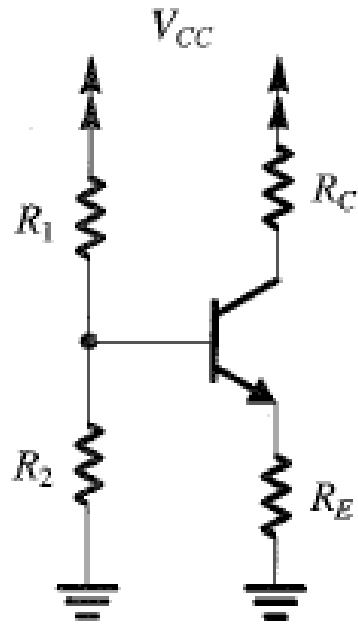
التحليل بيانياً Graphical Analysis

- يتقاطع خط الحمل مع مجموعة منحنيات تيار المجمع.
- النقطة التي يتقاطع فيها هذا الخط مع المنحنى بقيمة I_B المحددة سابقاً هي النقطة Q.



- تحدد إحداثيات نقطة Q قيمة تيار المجمع I_C والجهد V_{CE} .
- عادة تكون Q في منتصف المنطقة النشطة.

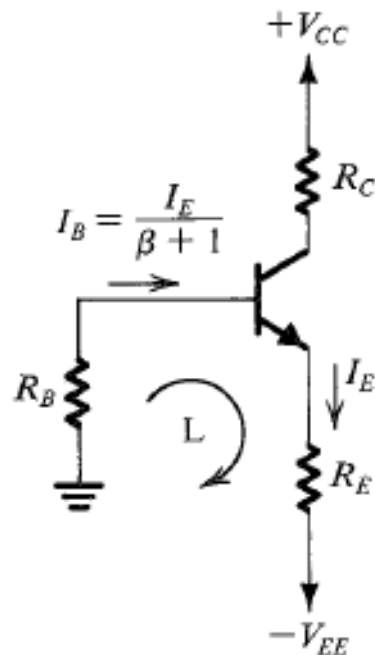
BJT Biasing in BJT Amplifier Circuits



The Classical Bias Arrangement

1- طريقة الانحياز التقليدي

مجزئ لجهد مصدر واحد

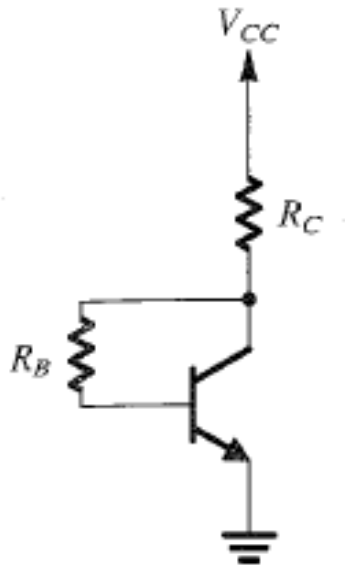


2- طريقة الانحياز التقليدي

بمصدرين جهد.

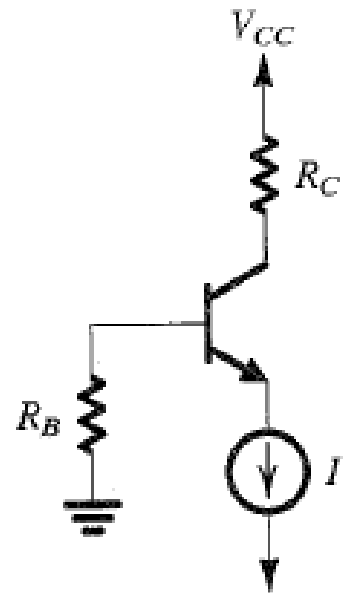
A Two-Power Supply Version of The Classical Bias Arrangement

BJT Biasing in BJT Amplifier Circuits



Biasing Using a Collector-to-Base Feedback Resistor

3- الانحياز باستخدام مقاومة التغذية العكسية بين القاعدة والمجمع



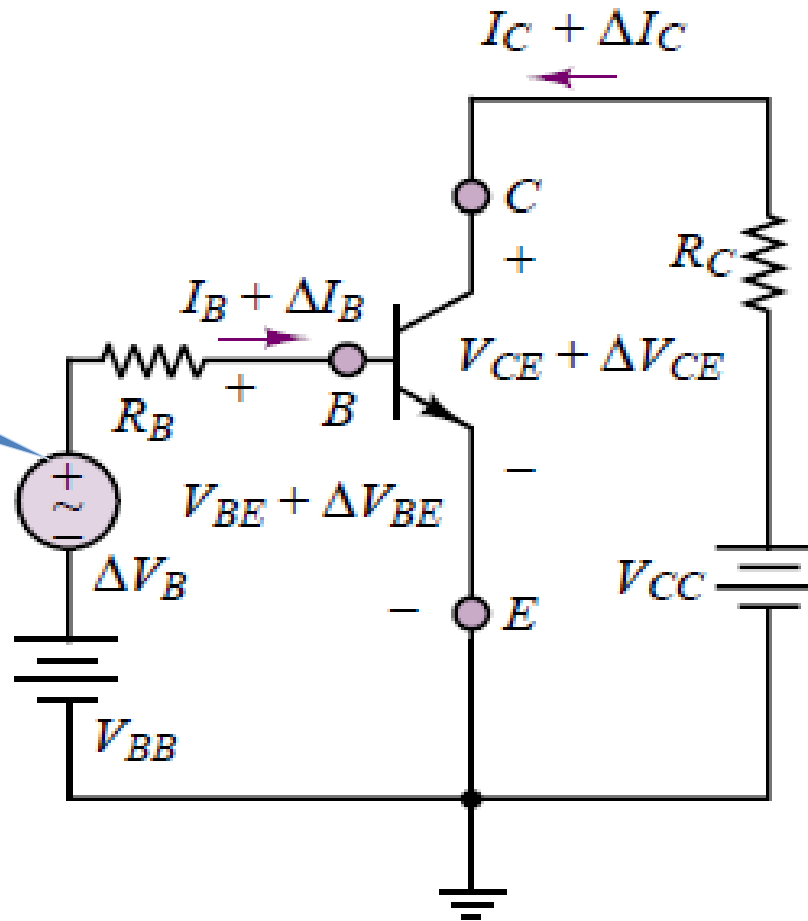
Biasing Using a Constant-Current Source

4- الانحياز باستخدام مصدر تيار ثابت

الترانزستور كمكبر The Transistor as an Amplifier

المكبر بباعث مشترك BJT CE Amplifier

تمثل الإشارة المراد تكبيرها بالمصدر المتردد



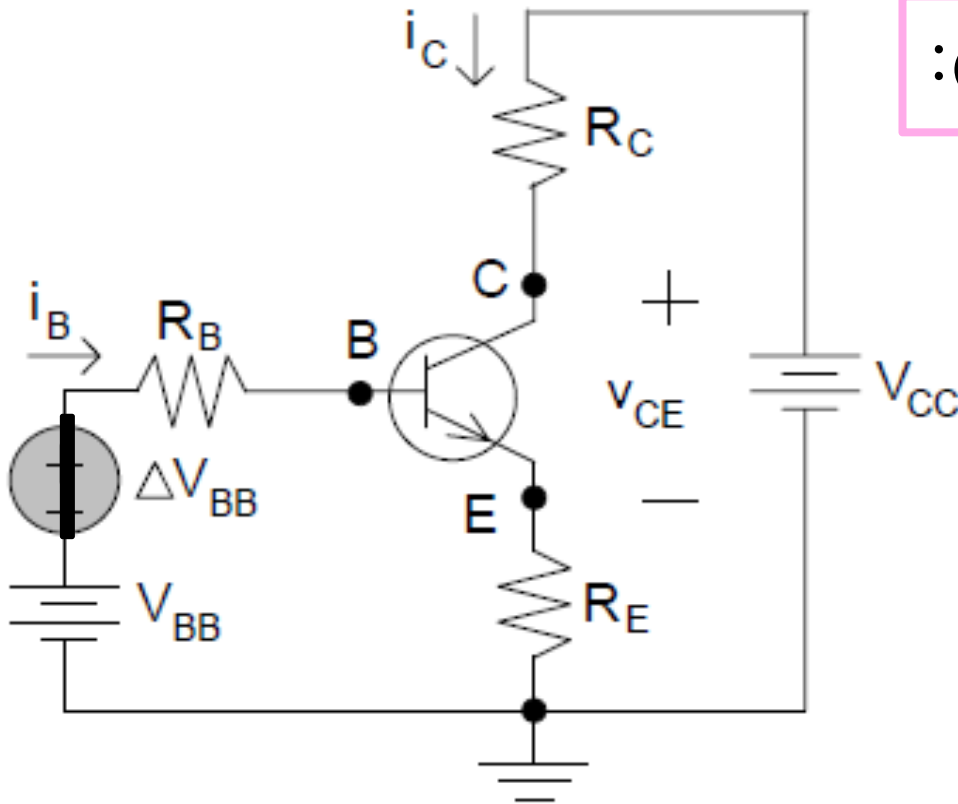
دائرة المكبر الأساسية

ليعمل الترانزستور كمكبر يجب تمييزه ليعمل في المنطقة النشطة

The Transistor as an Amplifier الترانزستور كمكبر

لتحليل دائرة المكبر بيانياً نقوم بالخطوات التالية:

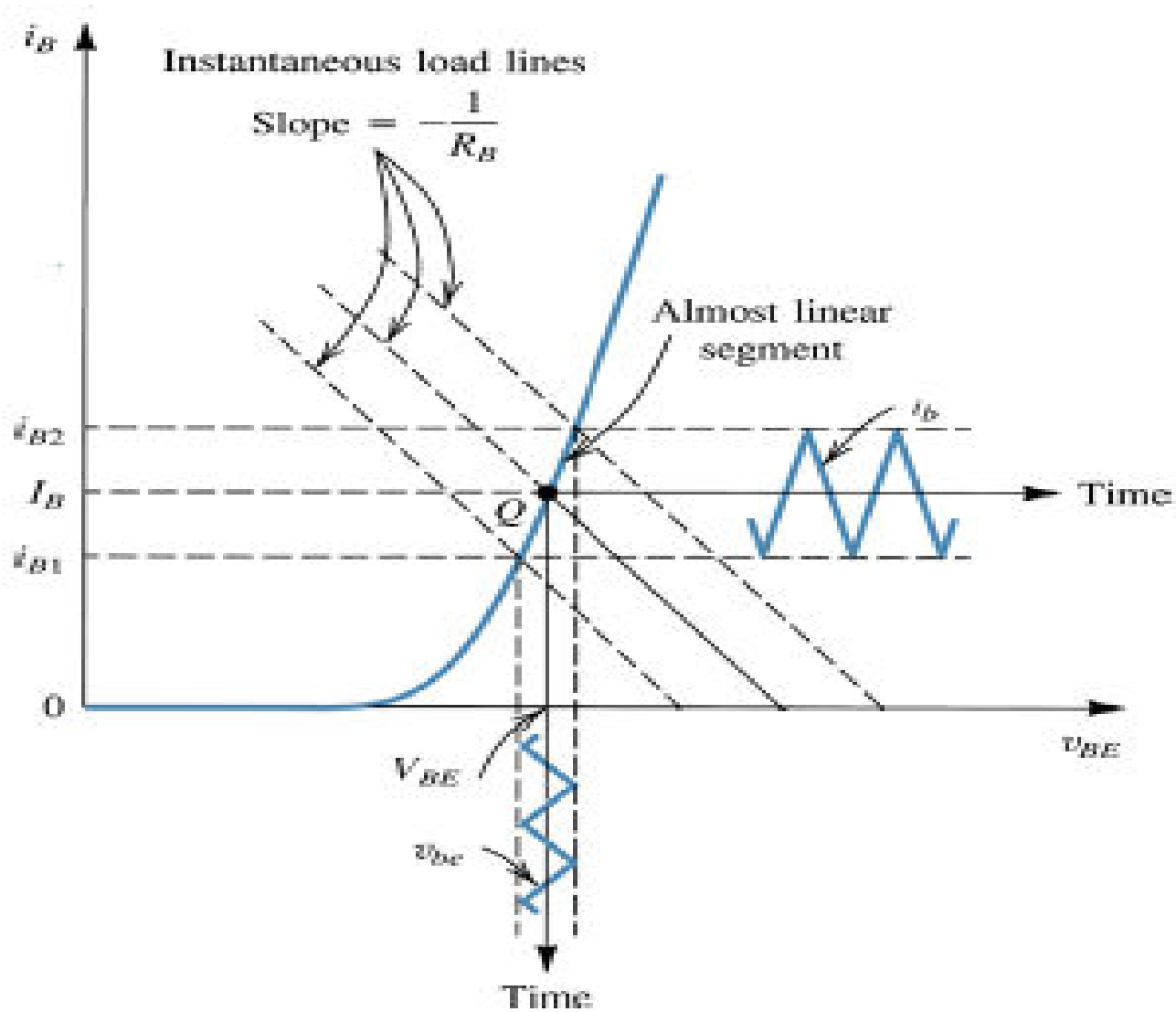
نبدأ بالحالة المستمرة (DC condition):



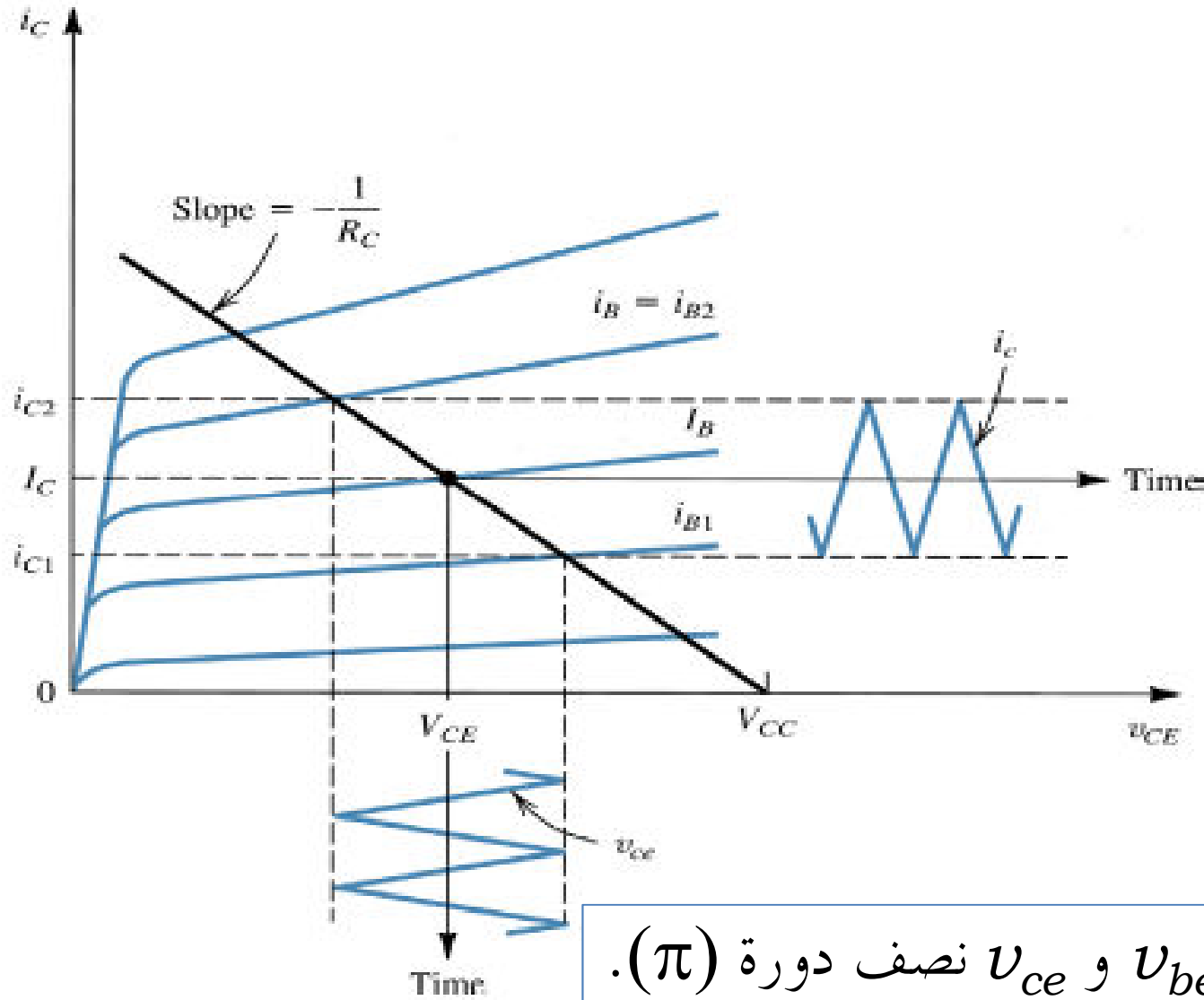
- تستبدل المصادر المترددة بدوائر قصر.

- تحدد إحداثي نقطة التشغيل I_B, V_{BE} ، ثم $Q(I_C, V_{CE})$.

-تطبيق إشارة جهد صغيرة Δv_b (a small voltage signal) وإيجاد i_B المقابلة.



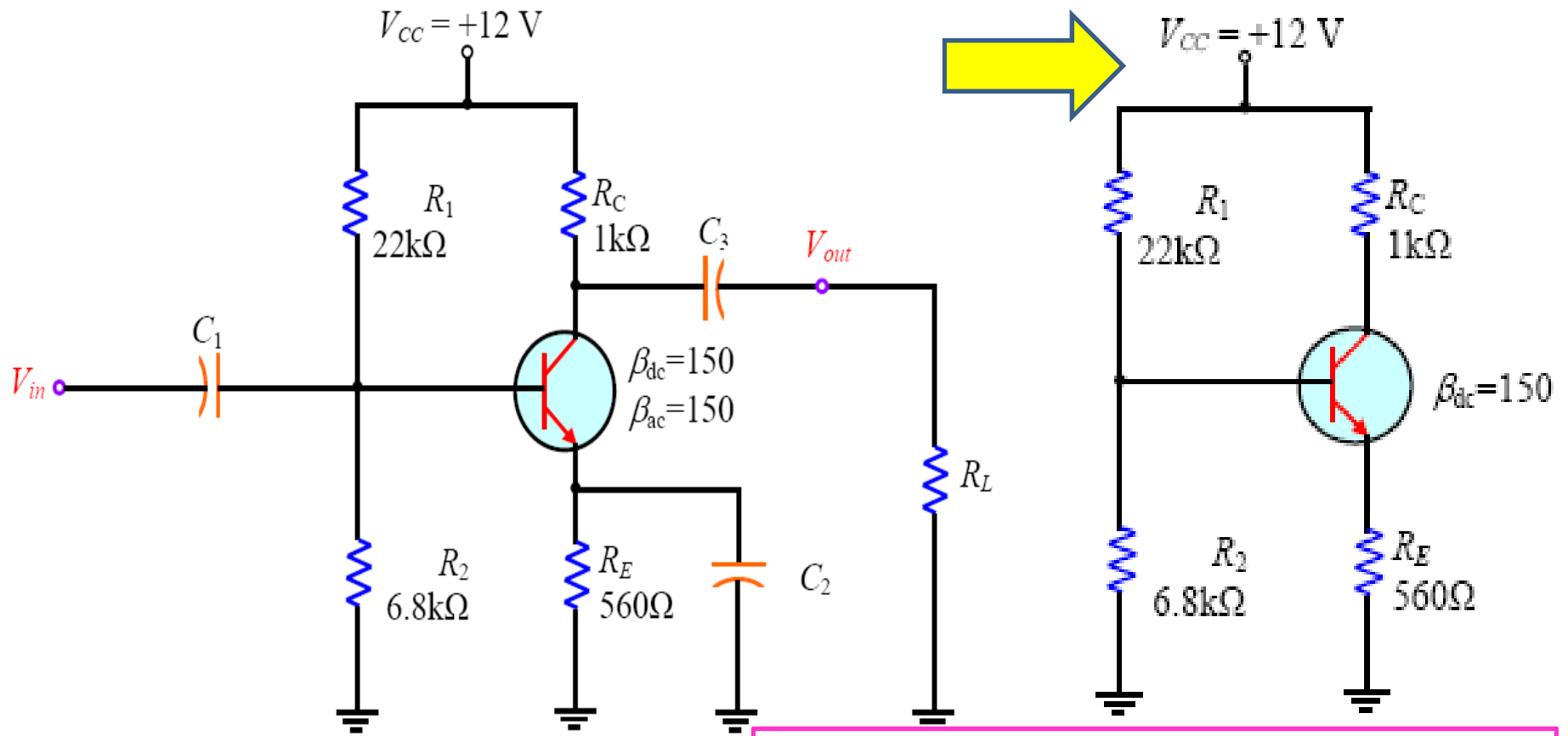
إيجاد v_{ce} المقابلة. والتأكد ما إذا كان الترانزستور سيبقى يعمل في المنطقة النشطة.



فرق الطور بين الجهد v_{ce} و v_{be} نصف دورة (π).

مكبر الباعث المشترك

التحليل في حالة التيار المستمر

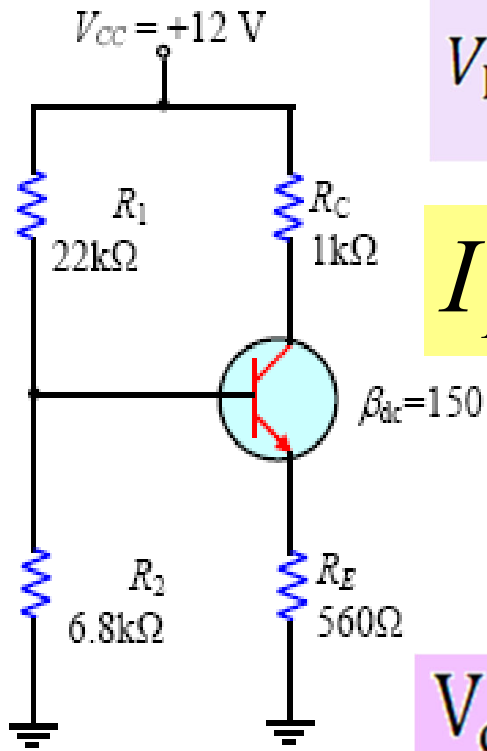


R_E ولم تحذف R_L لماذا حذف

مكبر الباعث المشترك

التحليل في حالة التيار المستمر

$$V_B, V_E, V_C, V_{CE}, I_E, I_C, I_B$$



$$V_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left(\frac{6.8 \text{ K}\Omega}{28.8 \text{ K}\Omega} \right) 12 \text{ V} = 2.83 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{2.83 - 0.7}{560} = 3.8 \text{ mA}$$

$$I_C \cong 3.8 \text{ mA}$$

$$V_E = V_{RE} = R_E I_E$$

$$560 \times 3.8 \times 10^{-3} = 2.13 \text{ V}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$= 12 - (3.8 \text{ mA})(1 \text{ K}\Omega) = 8.2 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 8.2 \text{ V} - 2.13 \text{ V} = 6.07 \text{ V}$$

مكبر الباعث المشترك

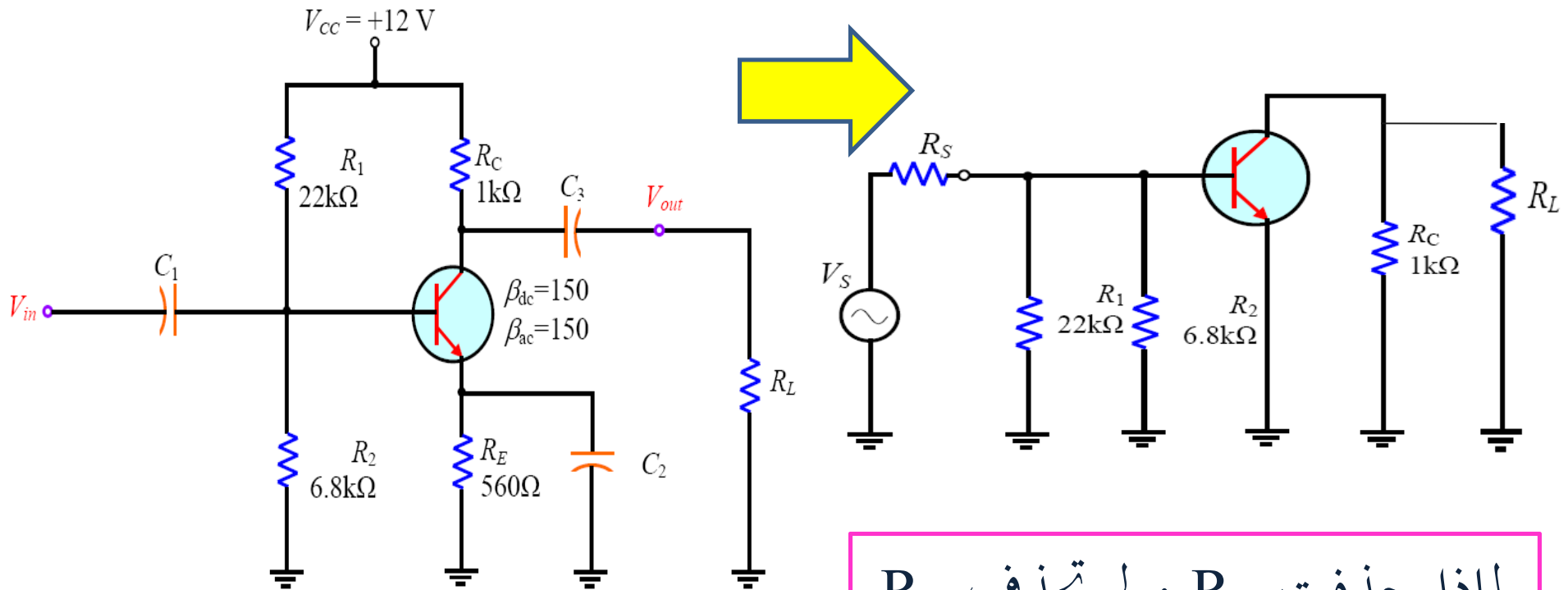
التحليل في حالة التيار المتردد

للتفريق بينها e, b, c في حالة التحليل للتيار المتردد نستخدم الرموز الصغيرة E, B, C وبين حالة التحليل للتيار المستمر

- قصر كل المكثفات.
- قصر جميع مصادر التيار المستمر وتحويلها لأرضي.
- التحليل بين دائرة الدخل والخرج.

مكبر الباعث المشترك

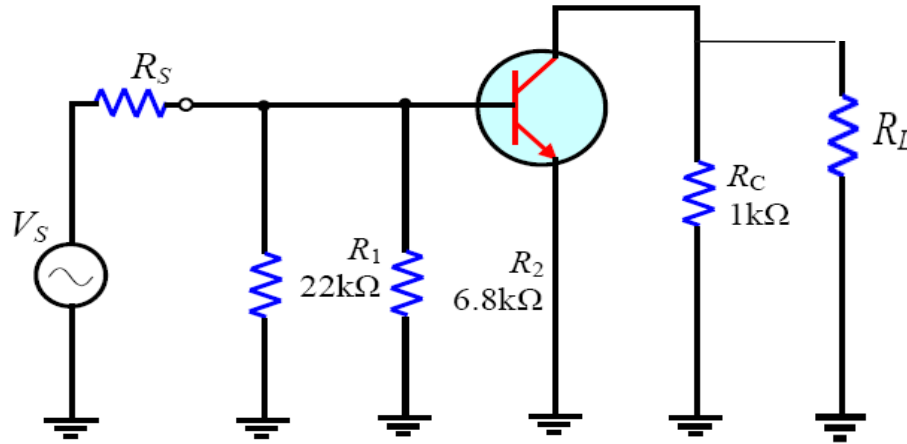
التحليل في حالة التيار المتردد



لماذا حذف R_E ولم تحذف R_L

مكبر الباعث المشترك

التحليل في حالة التيار المتردد



المقاومة الداخلية
للباعث r'_e

مقاومة الوصلة BEJ للتيار المتردد
(منخفضة)

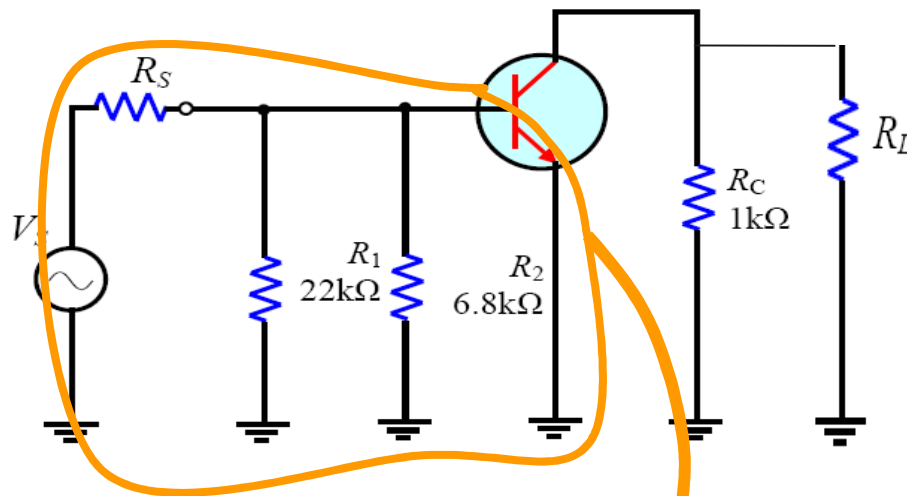
يمكن حسابها من:

$$r'_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E}$$

مكبر الباعث المشترك

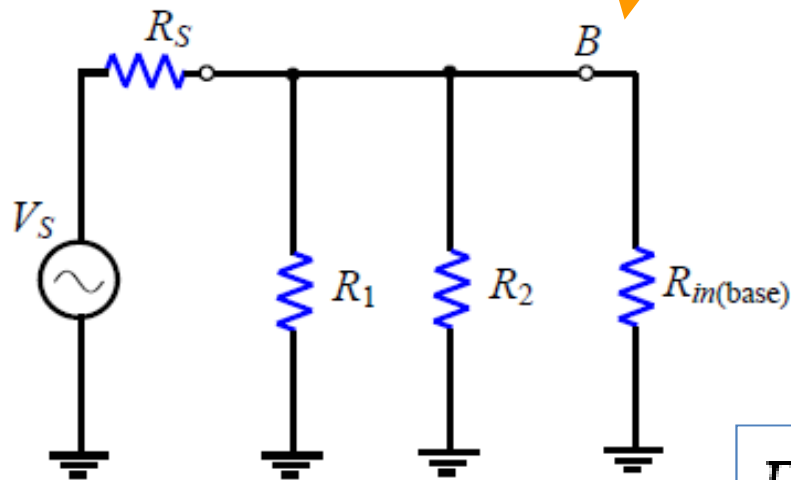
التحليل في حالة التيار المتردد

تيار الباعث



$$I_e = \frac{V_b}{r'_e}$$

مقاومة القاعدة (الدخل)

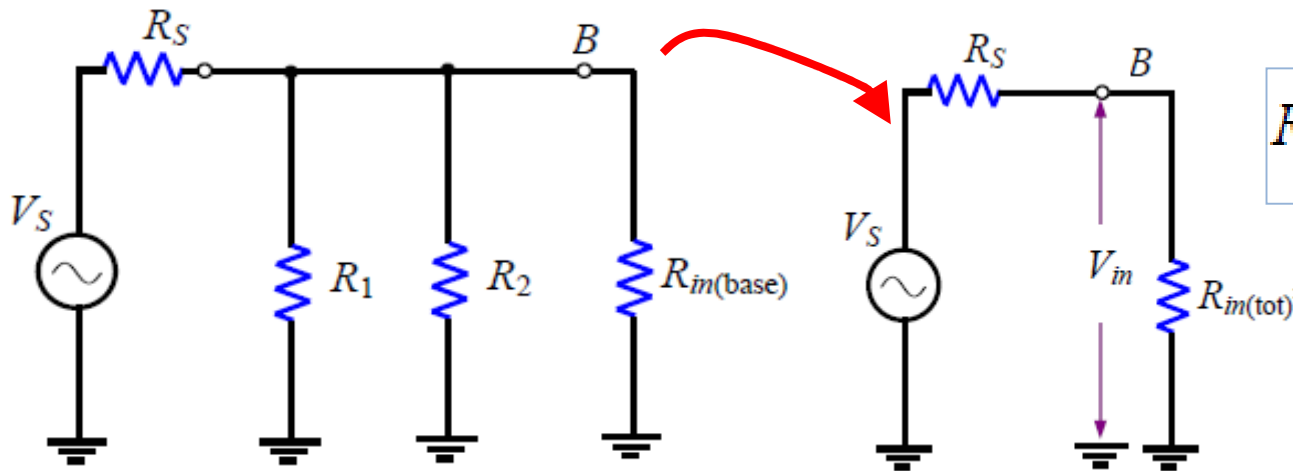


$$R_{in(base)} = \frac{V_b}{I_b} = \frac{I_e r'_e}{\left(\frac{I_e}{\beta_{ac}} \right)}$$

$$R_{in(base)} = \beta_{ac} r'_e$$

مكبر الباعث المشترك

التحليل في حالة التيار المتردد



$$R_{in(tot)} = R_1 // R_2 // R_{in(base)}$$

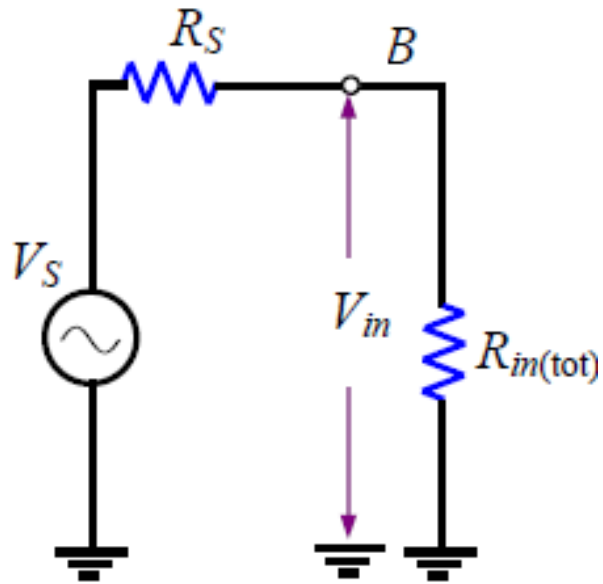
$$V_b = \left(\frac{R_{in(tot)}}{R_s + R_{in(tot)}} \right) V_s$$

جهد القاعدة

مكبر الباعث المشترك

التحليل في حالة التيار المتردد

جهد القاعدة



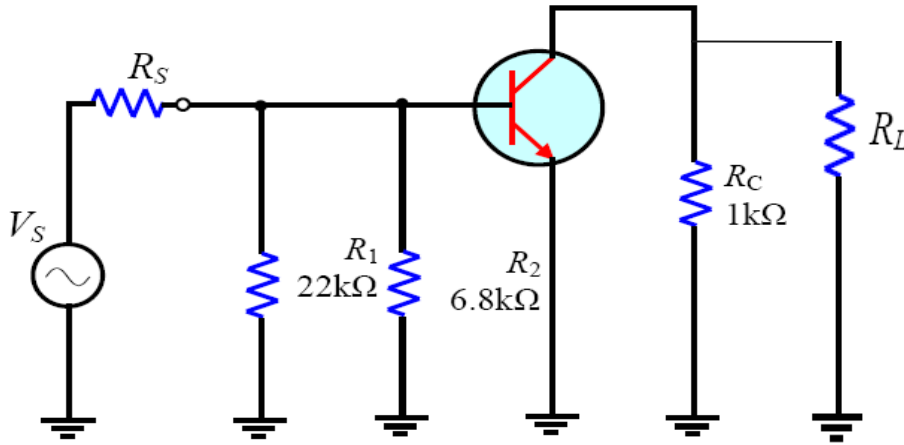
$$V_b = \left(\frac{R_{in(tot)}}{R_s + R_{in(tot)}} \right) V_s$$

إذا كانت $R_s \ll R_{in(tot)}$

$$V_s \cong V_b$$

مكبر الباعث المشترك

التحليل في حالة التيار المتردد



مقاومة الخرج

مقاومة الخرج لدائرة مكبر الباعث
المشترك تساوي:

$$R_{out} = R_C \parallel R_L$$

R_C لدائرة مكبر الباعث المشترك تساوي مقاومة المجمع R_{out} مقاومة الخرج
(بدون مقاومة حمل)

مكبر الباعث المشترك

التحليل في حالة التيار المتردد

كسب الجهد

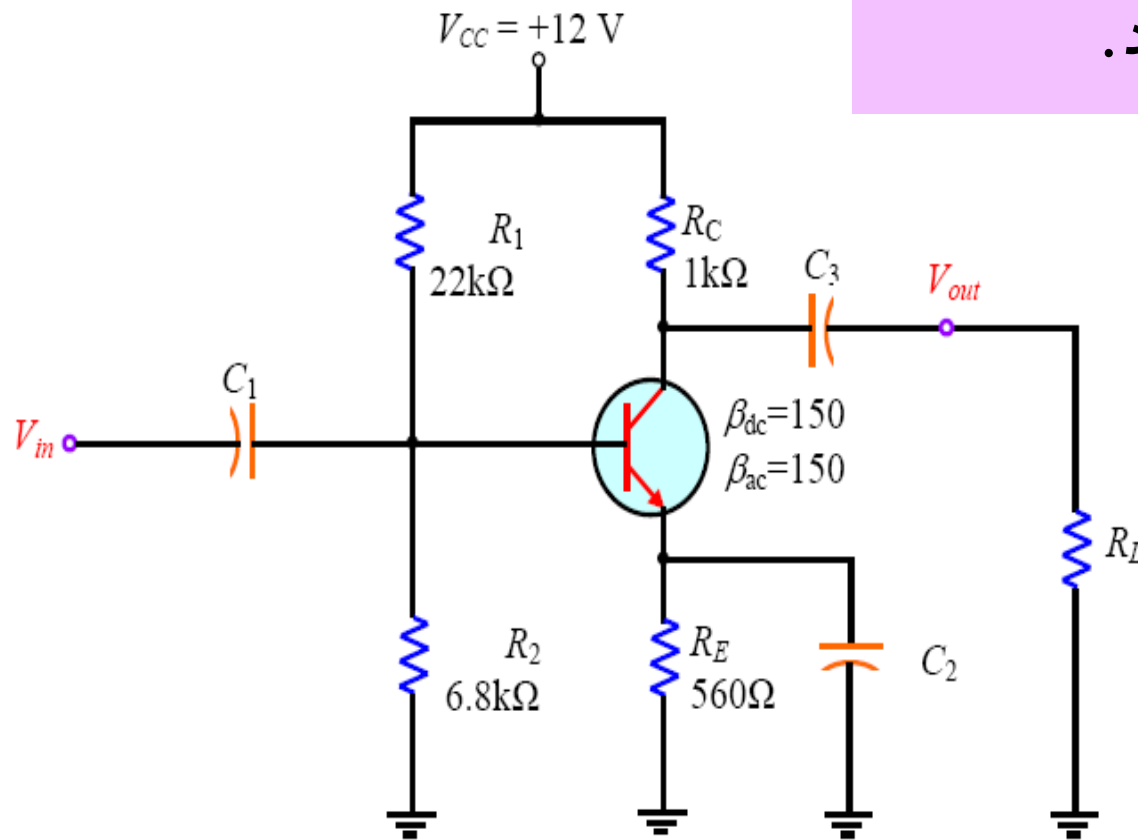
يمكن حساب التكبير بعد حساب مقاومة الدخل ومقاومة الخرج لدائرة مكبر الباعث المشترك:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_c}{V_b}$$

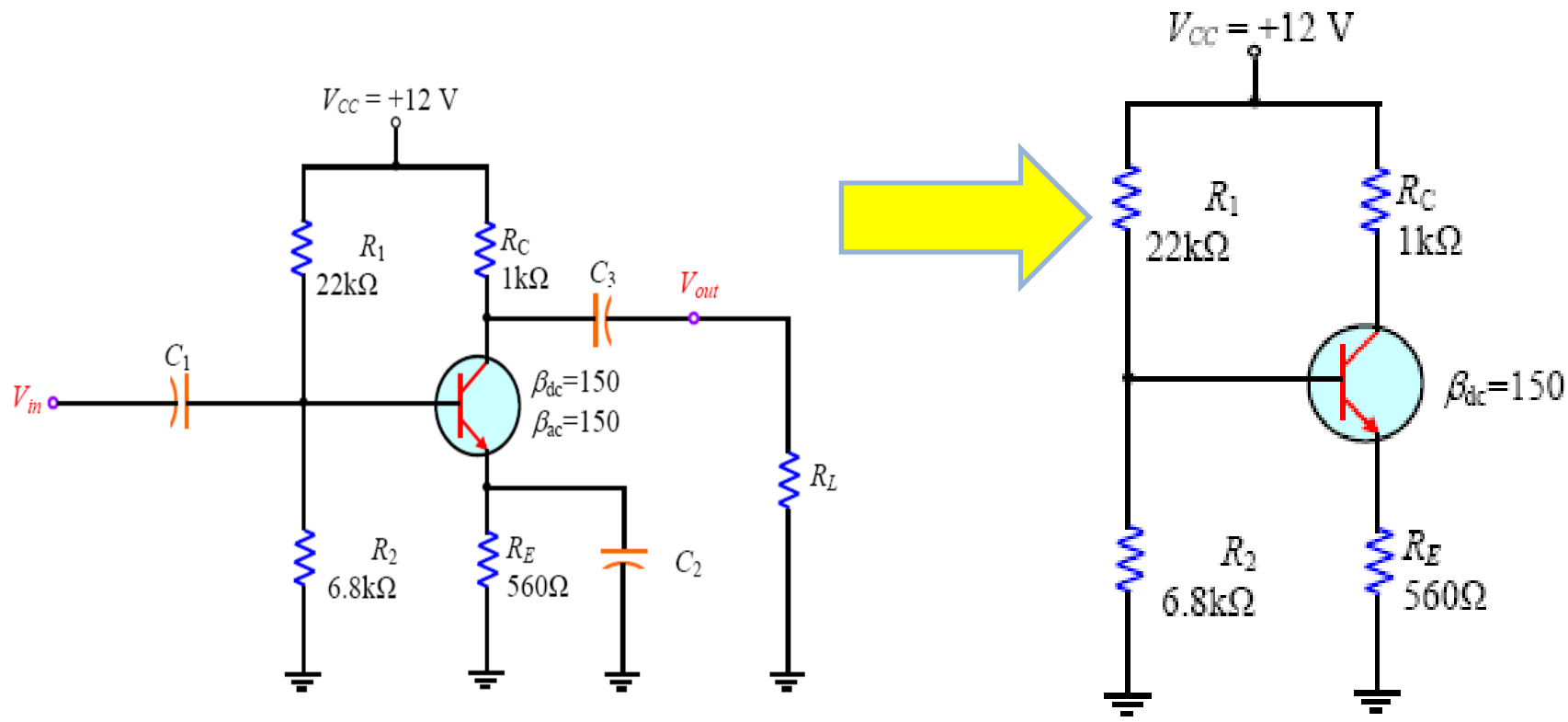
$$A_v = \frac{I_e R_C}{I_e r'_e}$$

$$A_v = \frac{R_{out}}{r'_e}$$

1- احسبي مقاومة الباعث
الداخلية للتيار المتردد.



$$r_e' = \frac{25 \text{ mV}}{I_E}$$

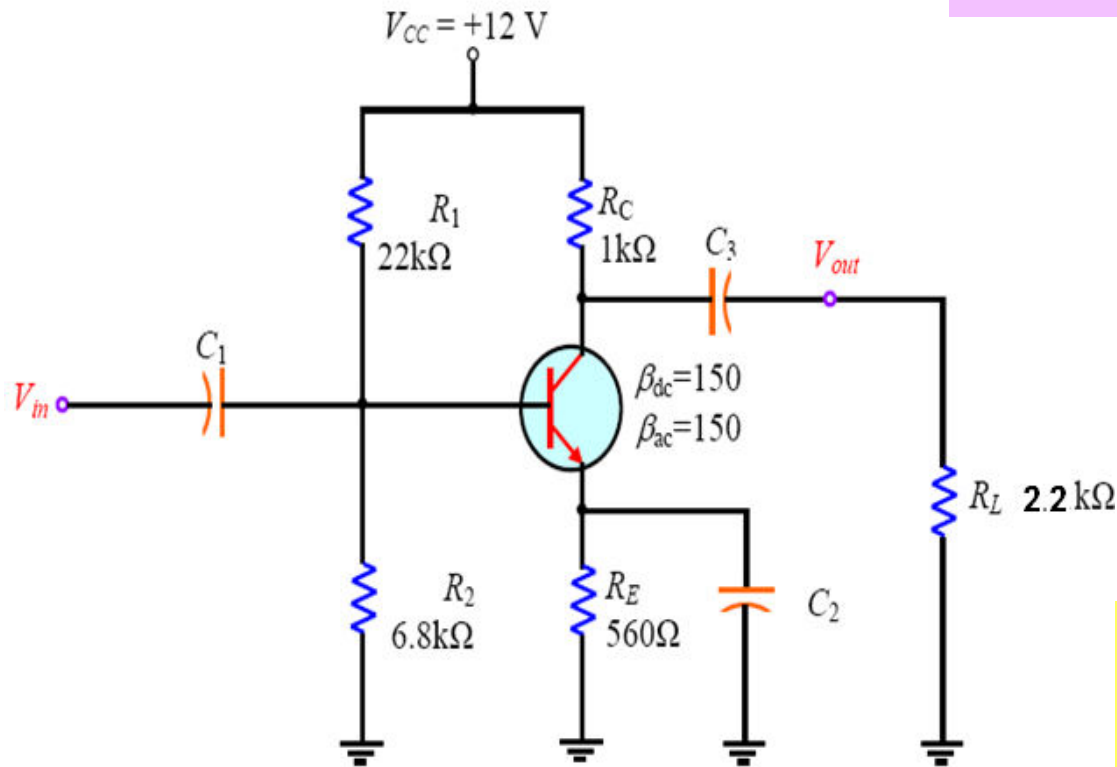


$$V_B \cong \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left(\frac{6.8\text{K}\Omega}{28.8\text{K}\Omega} \right) 12\text{V} = 2.83\text{V}$$

$$I_E = \frac{2.83 - .7}{560} = 3.8\text{mA}$$

$$r_e = \frac{25}{3.8} = 6.58\Omega$$

2- احسبي التكبير للجهد.



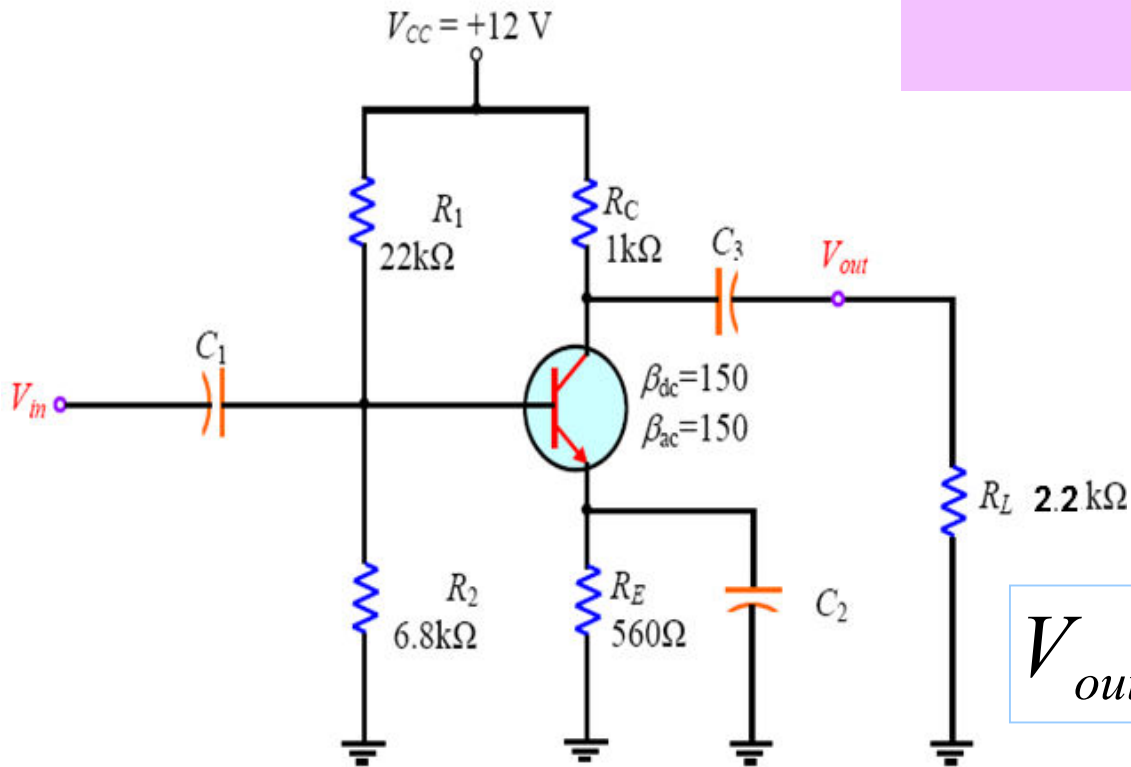
$$A_v = \frac{R_{out}}{r_e}$$

$$R_{out} = R_C \parallel R_L$$

$$R_{out} = \frac{2.2 * 1}{3.2} = 688\Omega$$

$$A_v = \frac{688}{6.58} = 105$$

3- احسبي جهد الخرج إذا كان
جهد المصدر 2 mV



$$A_v = \frac{688}{6.58} = 105$$

$$V_{out} = 105 * 2 = 210\text{ mV}$$

لمكبر باعثة مشترك مع موزع جهد المواصفات: $R_{in(base)}=68\text{ k}\Omega$, $R_1=33\text{ k}\Omega$, $R_2=15\text{ k}\Omega$. مقاومة الدخل تساوي:
أ. $(68\text{ k}\Omega)$ ، ب. $(8.95\text{ k}\Omega)$ ، ج. $(22.2\text{ k}\Omega)$ ، د. $(12.3\text{ k}\Omega)$.

7. لمكبر باعثة مشترك مقاومة حمل $10\text{ k}\Omega$. إذا كان $r'_e=10\ \Omega$, $R_C=2.2\text{ k}\Omega$ كسب الجهد يساوي: أ. (220) ، ب. (1000) ، ج. (10) ، د. (180) .